

Sít TN, jmenovité napětí AC 230 / 400 V.

K ověření selektivity byly použity údaje výrobce

K výpočtu byly použity následující normy : ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, PNE 33 0000-1 ed. 5, ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 a ČSN 33

K zobrazení vypínacích charakteristik byly použity údaje výrobce

Charakteristiky jsou vedeny v 75% proudového rozptylového pásma

Pro výpočty zkratů byla použita ČSN EN 60909-0

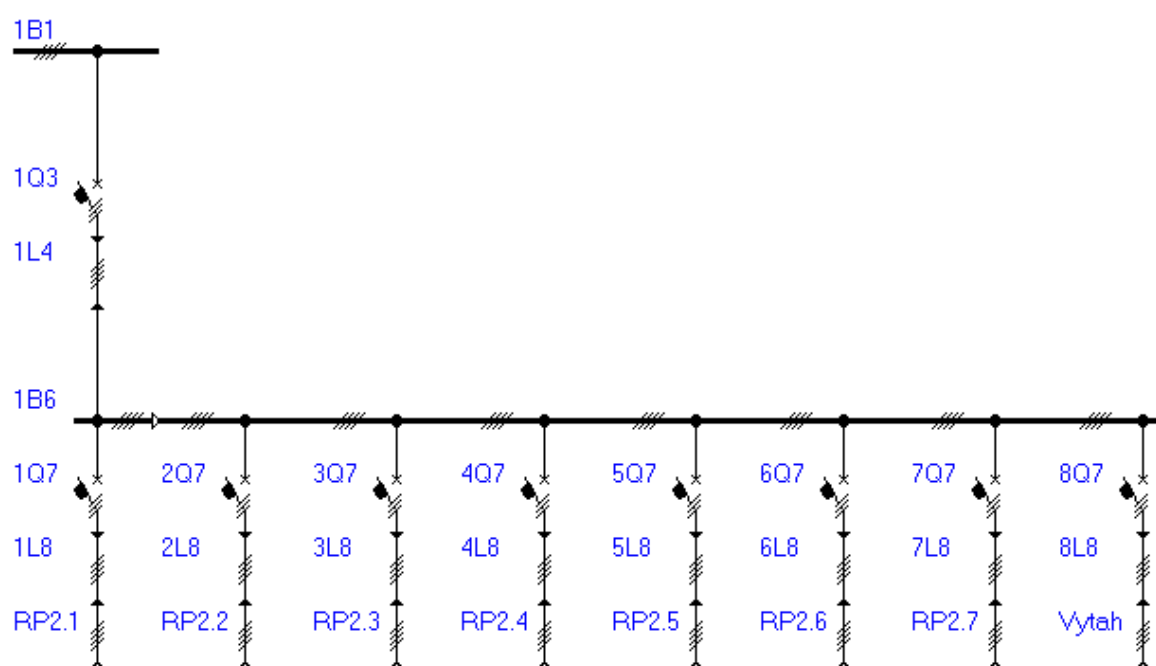
Soupiska strojů, přístrojů a vodičů

Veškeré přístroje jsou uvedeny pouze v základním provedení

Doplňkové příslušenství naleznete v katalogu nebo Konfiguratoru OEZ

Přístroje označené * nemají úplné typové označení a je nutné je vyhledat v katalogu nebo Konfiguratoru OEZ

1Q3	BC160NT305-80-D	1 ks
1L4	1-CYKY4x50	50 m
1Q7	LTN-25B-3	1 ks
1L8	CYKY4x10	20 m
2Q7	LTN-25B-3	1 ks
2L8	CYKY4x10	20 m
3Q7	LTN-25B-3	1 ks
3L8	CYKY4x10	20 m
4Q7	LTN-25B-3	1 ks
4L8	CYKY4x10	20 m
5Q7	LTN-25B-3	1 ks
5L8	CYKY4x10	20 m
6Q7	LTN-25B-3	1 ks
6L8	CYKY4x10	20 m
7Q7	LTN-25B-3	1 ks
7L8	CYKY4x10	20 m
8Q7	LTN-32C-3	1 ks
8L8	CYKY4x6	20 m



1B1	Sít TN U ₂ = 242/420 V I _n = 80 A dU = 1.1 %	I _{k''} = 5.99 kA i _p = 9.09 kA	Napájení z ER
1Q3	BC160NT305-80-D I _n = 80 A I _R = 80 A	I _{cu} = 25 kA i _o = 8.31 kA	I _R = 80 A (1.00x80 A), I _i = 800 A Z _s (5s) = 261 mOhm, I _a = 885 A, R(50V/5s) = 56 mOhm
1L4	1-CYKY4x50 I _z = 144 A t _m = 46 °C dU = 0.5 % I _{2t} < k2S2	I _{k''} = 4.21 kA i _p = 6.15 kA	50 m na stěně (C) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (183 mOhm < 261 mOhm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforovanou Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : Seskupené ve svazku, zapuštěné nek
1B6	Sběrnice B = 0.3 U = 414 V (Un + 3.4%)	I _{k''} = 4.21 kA i _p = 6.15 kA	O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (183 mOhm < 261 mOhm) Sběrnice v RH2
1Q7	LTN-25B I _n = 25 A	I _{cn} = 10 kA i _o = 2.54 kA	I _i = 112.50 A Z _s (5s) = 1.86 Ohm, I _a = 124 A, R(50V/5s) = 402 mOhm 1Q3-1Q7 selektivní minimálně do 684 A
1L8	CYKY4x10 I _z = 57 A t _m = 41 °C dU = 0.4 % I _{2t} < k2S2	(I _{k''} = 2.64 kA) i _o = 1.74 kA	20 m na stěně (C) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforovanou Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě
RP2.1	Vývod I = 25 A x B = 25 A cos φ = 0.95 I = 25.0 A B = 1 U = 412 V (Un + 3.0%)	i _o = 1.74 kA	(I _{k''} = 2.64 kA, i _p = 3.82 kA) O.K. Z _{sv} < Z _s (0,4s) (261 mOhm < 1.86 Ohm)
2Q7	LTN-25B I _n = 25 A	I _{cn} = 10 kA i _o = 2.54 kA	I _i = 112.50 A Z _s (5s) = 1.86 Ohm, I _a = 124 A, R(50V/5s) = 402 mOhm 1Q3-2Q7 selektivní minimálně do 684 A
2L8	CYKY4x10 I _z = 57 A t _m = 41 °C dU = 0.4 % I _{2t} < k2S2	(I _{k''} = 2.64 kA) i _o = 1.74 kA	20 m na stěně (C) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforovanou Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě
RP2.2	Vývod I = 25 A x B = 25 A cos φ = 0.95 I = 25.0 A B = 1 U = 412 V (Un + 3.0%)	i _o = 1.74 kA	(I _{k''} = 2.64 kA, i _p = 3.82 kA) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm)
3Q7	LTN-25B I _n = 25 A	I _{cn} = 10 kA i _o = 2.54 kA	I _i = 112.50 A Z _s (5s) = 1.86 Ohm, I _a = 124 A, R(50V/5s) = 402 mOhm 1Q3-3Q7 selektivní minimálně do 684 A

3L8	CYKY4x10 I _z = 57 A dU = 0.4 %	t _m = 41 °C I _{2t} < k ₂ S ₂	(I _k ' = 2.64 kA) i _o = 1.74 kA	20 m na stěně (C) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforované Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě
RP2.3	Vývod I = 25 A x B = 25 A cos φ _i = 0.95 I = 25.0 A B = 1 U = 412 V (U _n + 3.0%)		i _o = 1.74 kA	(I _k ' = 2.64 kA, i _p = 3.82 kA) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm)
4Q7	LTN-25B I _n = 25 A		I _{cn} = 10 kA i _o = 2.54 kA	I _i = 112.50 A Z _s (5s) = 1.86 Ohm, I _a = 124 A, R(50V/5s) = 402 mOhm 1Q3-4Q7 selektivní minimálně do 684 A
4L8	CYKY4x10 I _z = 57 A dU = 0.4 %	t _m = 41 °C I _{2t} < k ₂ S ₂	(I _k ' = 2.64 kA) i _o = 1.74 kA	20 m na stěně (C) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforované Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě
RP2.4	Vývod I = 25 A x B = 25 A cos φ _i = 0.95 I = 25.0 A B = 1 U = 412 V (U _n + 3.0%)		i _o = 1.74 kA	(I _k ' = 2.64 kA, i _p = 3.82 kA) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm)
5Q7	LTN-25B I _n = 25 A		I _{cn} = 10 kA i _o = 2.54 kA	I _i = 112.50 A Z _s (5s) = 1.86 Ohm, I _a = 124 A, R(50V/5s) = 402 mOhm 1Q3-5Q7 selektivní minimálně do 684 A
5L8	CYKY4x10 I _z = 57 A dU = 0.4 %	t _m = 41 °C I _{2t} < k ₂ S ₂	(I _k ' = 2.64 kA) i _o = 1.74 kA	20 m na stěně (C) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforované Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě
RP2.5	Vývod I = 25 A x B = 25 A cos φ _i = 0.95 I = 25.0 A B = 1 U = 412 V (U _n + 3.0%)		i _o = 1.74 kA	(I _k ' = 2.64 kA, i _p = 3.82 kA) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm)
6Q7	LTN-25B I _n = 25 A		I _{cn} = 10 kA i _o = 2.54 kA	I _i = 112.50 A Z _s (5s) = 1.86 Ohm, I _a = 124 A, R(50V/5s) = 402 mOhm 1Q3-6Q7 selektivní minimálně do 684 A
6L8	CYKY4x10 I _z = 57 A dU = 0.4 %	t _m = 41 °C I _{2t} < k ₂ S ₂	(I _k ' = 2.64 kA) i _o = 1.74 kA	20 m na stěně (C) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforované Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě
RP2.6	Vývod I = 25 A x B = 25 A cos φ _i = 0.95 I = 25.0 A B = 1		i _o = 1.74 kA	(I _k ' = 2.64 kA, i _p = 3.82 kA) O.K. Z _{sv} < Z _s (5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm)

$$U = 412 \text{ V (} U_n + 3.0\% \text{)}$$

7Q7	LTN-25B In = 25 A	Icn = 10 kA io = 2.54 kA	li = 112.50 A Zs(5s) = 1.86 Ohm, Ia = 124 A, R(50V/5s) = 402 mOhm 1Q3-7Q7 selektivní minimálně do 684 A	u
7L8	CYKY4x10 Iz = 57 A tm = 41 °C dU = 0.4 % I2t < k2S2	(Ik"= 2.64 kA) io = 1.74 kA	20 m na stěně (C) O.K. Zsv < Zs(5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforované Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě	-
RP2.7	Vývod I = 25 A x B = 25 A cos fi = 0.95 I = 25.0 A B = 1 U = 412 V (Un + 3.0%)	io = 1.74 kA	(Ik"= 2.64 kA, ip = 3.82 kA) O.K. Zsv < Zs(5s) (262 mOhm < 1.86 Ohm)	u k
8Q7	LTN-32C In = 32 A	Icn = 10 kA io = 2.67 kA	li = 280 A Zs(5s) = 1.13 Ohm, Ia = 205 A, R(50V/5s) = 244 mOhm 1Q3-8Q7 selektivní minimálně do 684 A	u
8L8	CYKY4x6 Iz = 41 A tm = 78 °C dU = 1.0 % I2t < k2S2	(Ik"= 2.12 kA) io = 1.56 kA	20 m na stěně (C) O.K. Zsv < Zs(5s) (329 mOhm < 1.13 Ohm) Teplota okolí [st. C] : 30 Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforované Počet seskupených obvodů : 1 Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě	u
Vytah	Vývod I = 32 A x B = 32 A cos fi = 0.95 I = 32.0 A B = 1 U = 410 V (Un + 2.5%)	io = 1.56 kA	(Ik"= 2.12 kA, ip = 3.05 kA) O.K. Zsv < Zs(5s) (329 mOhm < 1.13 Ohm)	- u